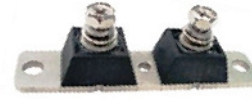
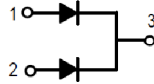


## Silicon Schottky Diode, 200A

### Features

- Guard Ring Protection
- Low forward voltage drop
- High surge current capability
- Up to 100V  $V_{RRM}$



TWIN TOWER PACKAGE

### Maximum Ratings ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

| Parameter                                            | Symbol      | Conditions                                         | MBR20045CT<br>(R) | MBR20060CT<br>(R) | MBR20080CT<br>(R) | MBR200100C<br>T(R) | Units |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Repetitive peak reverse voltage                      | $V_{RRM}$   |                                                    | 45                | 60                | 80                | 100                | V     |
| RMS reverse voltage                                  | $V_{RMS}$   |                                                    | 32                | 42                | 56                | 70                 | V     |
| DC blocking voltage                                  | $V_{DC}$    |                                                    | 45                | 60                | 80                | 100                | V     |
| Average forward current                              | $I_{F(AV)}$ | $T_C \leq 135^\circ\text{C}$                       | 200               | 200               | 200               | 200                | A     |
| Non-repetitive forward surge current, half sine-wave | $I_{FSM}$   | $T_C = 25^\circ\text{C}$<br>$t_p = 8.3 \text{ ms}$ | 1500              | 1500              | 1500              | 1500               | A     |

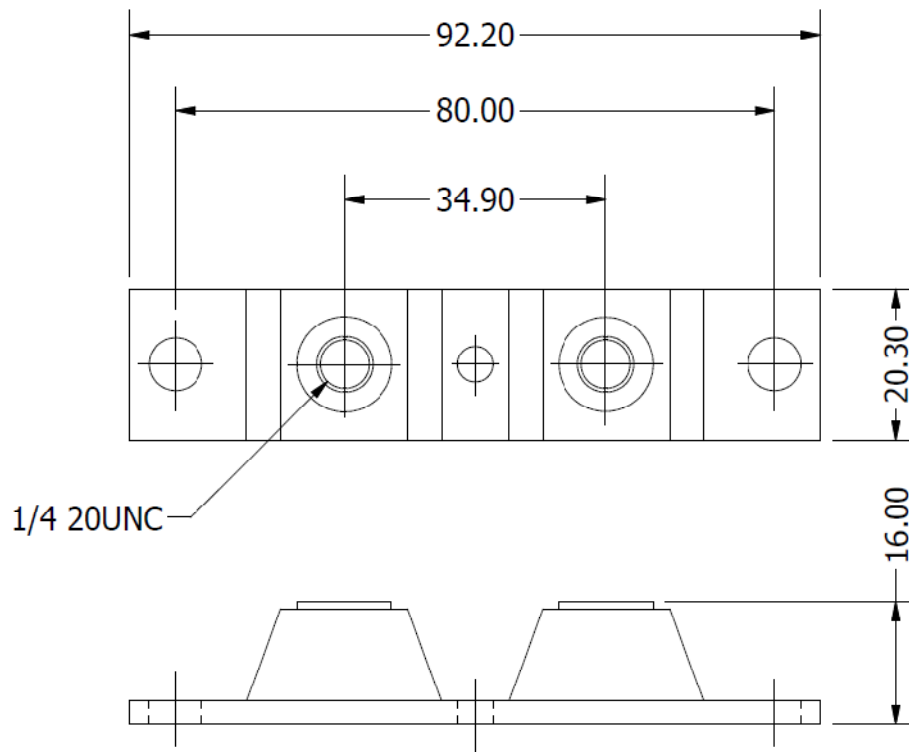
### Electrical Characteristics ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

| Parameter          | Symbol | Conditions                                        | MBR20045CT<br>(R) | MBR20060CT<br>(R) | MBR20080CT<br>(R) | MBR200100C<br>T(R) | Units |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| DC forward voltage | $V_F$  | $I_F = 100 \text{ A}$<br>$T_J = 25^\circ\text{C}$ | 0.68              | 0.76              | 0.88              | 0.88               | V     |
| DC reverse current | $I_R$  | $V_R = 20 \text{ V}$<br>$T_J = 25^\circ\text{C}$  | 5                 | 5                 | 5                 | 5                  | mA    |
|                    |        | $V_R = 20 \text{ V}$<br>$T_J = 125^\circ\text{C}$ | 200               | 200               | 200               | 200                |       |

### Thermal Characteristics ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

| Parameter                            | Symbol         |  | MBR20045CT<br>(R) | MBR20060CT<br>(R) | MBR20080CT<br>(R) | MBR200100C<br>T(R) | Units              |
|--------------------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Thermal resistance junction to case  | $R_{thJ-C}$    |  | 0.5               | 0.5               | 0.5               | 0.5                | $^\circ\text{C/W}$ |
| Operating, storage temperature range | $T_J, T_{stg}$ |  | - 40 to +175      | - 40 to +175      | - 40 to +175      | - 40 to +175       | $^\circ\text{C}$   |

## Package Outline



ALL DIMENSIONS IN MM

## Ordering Table

| <i>MBR</i> | <i>200</i> | <i>20</i> | <i>CT</i> |
|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b>  |

- 1 – Device Type
  - > MBR = Schottky Barrier Diode Module
- 2 – Current Rating =  $I_{F(AV)}$
- 3 – Voltage =  $V_{RRM}$
- 4 – Polarity
  - > CT = Normal (Cathode to Base)
  - > CTR = Reverse (Anode to Base)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.